

kingston.com/epop

ePoP

ePoP — встраиваемая память типа «корпус на корпусе» для носимых устройств

Компоненты ePoP компании Kingston — это в высокой степени интегрированные компоненты, соответствующие стандарту JEDEC, которые объединяют встраиваемую мультимедийную карту (eMMC) и модуль Low-Power Double Data Rate (LPDDR) DRAM в решении типа «корпус на корпусе» (PoP). Компонент ePoP устанавливается непосредственно поверх совместимой хост-системы на кристалле (SoC), что уменьшает занимаемое пространство на печатной плате (ПП) и обеспечивает оптимальную производительность. ePoP — идеальное решение для областей применения с ограниченным пространством, таких как носимые устройства.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компоненты ePoP, устанавливаемые непосредственно поверх хост-системы на кристалле (SoC), представляют собой идеальное решение для областей применения с малым форм-фактором, таких как носимые устройства.
- Память DRAM с низким энергопотреблением и оптимизированное встроенное ПО хранилища данных снижают энергопотребление, обеспечивая при этом высокую производительность, необходимую для носимых устройств с питанием от аккумулятора.
- Упрощает проектирование систем, уменьшает время выхода на рынок и сокращает этап оценки качества продукции.
- Доступно несколько конфигураций встроенного ПО, которые наилучшим образом соответствуют требованиям вашей области применения к производительности, мощности и сроку службы.

РЫНОЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ



Интернет вещей



Носимые устройства



Устройства дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR)

НОМЕРА ПО КАТАЛОГУ И СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТОВ EPOP

ePoP на основе LPDDR3

Номер по каталогу	Емкость		Стандарт		Корпус	FBGA	Рабочая температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	10x10x0.8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5.0	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x на основе ePoP

Номер по каталогу	Емкость		Стандарт		Корпус	FBGA	Рабочая температура
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C

* Режим pSLC для увеличения эксплуатационного ресурса

